| 中文摘要 |
|-----------------------|
| 英文摘要 |
| |
| |
| 日 銾V |
| 表目錄 |
| 圖目錄IX |
| 第一章 諸論1 |
| 1.1 前言1 |
| 1.2 塑膠膜片之抗反射技術現況5 |
| 1.2.1 製程技術的種類 |
| 1.2.2 塑膠膜片塗佈技術問題 |
| 1.3 研究動機 |
| 1.4 研究目的12 |
| 第二章 文獻回顧與基礎理論13 |
| 2.1 次波長結構應用於抗反射發展歷史13 |
| 2.1.1 次波長結構之光學理論探討15 |
| 2.1.2 次波長結構之製程技術16 |
| 2.2 抗反射之光學理論概述25 |
| 2.2.1 等效介質理論(EMT)25 |
| 2.2.2 嚴格耦合波理論(RCWA)26 |
| |

| 2.2.3 有限時域差分法(FDTD) | 27 |
|--------------------------|----|
| 2.3 奈米針尖陣列製作技術 | 29 |
| 2.3.1 自組裝遮蔽物乾蝕刻機制 | 29 |
| 第三章 三維奈米針尖陣列的光學模擬分析 | 32 |
| 3.1 FullWAVE 軟體簡介 | 32 |
| 3.2 奈米針尖結構的設計 | 33 |
| 3.2.1 三角錐結構設計 | 33 |
| 3.2.2 半圓形柱結構設計 | 34 |
| 3.3 光學模擬分析結果與討論 | 35 |
| 3.3.1 模擬分析結果 | 35 |
| 3.3.2 結果比較與討論 | |
| 第四章 實驗方法與設備 | 40 |
| 4.1 實驗流程 | 40 |
| 4.2 實驗材料 | 41 |
| 4.3 實驗設備 | 41 |
| 4.3.1 電子迴旋共振微波電漿化學氣相沈積系統 | 41 |
| 4.3.2 精密微電鑄系統 | 43 |
| 4.3.3 奈米轉印-微熱壓成形機 | 45 |
| 4.4 分析儀器設備 | 47 |
| 4.4.1 場發射掃描式電子顯微鏡 | 47 |
| 4.4.2 紫外光/可見光/紅外光分光光譜儀 | 48 |

| 4.4.3 接觸角量測儀 | 49 |
|---------------------------|----|
| 4.5 實驗步驟 | 51 |
| 4.5.1 自組裝之乾蝕刻技術製備奈米針尖陣列 | 51 |
| 4.5.2 精密微電鑄奈米針尖陣列模具 | 52 |
| 4.5.3 奈米針尖結構熱壓成形於塑膠基材 | 53 |
| 第五章 結果與討論 | 57 |
| 5.1 矽奈米針尖陣列特性分析 | 57 |
| 5.1.1 矽奈米針尖之表面形貌分析 | 57 |
| 5.1.2 矽奈米針尖陣列之反射率光譜分析 | 59 |
| 5.2 精密微電鑄奈米針尖陣列 | 59 |
| 5.3 塑膠膜片奈米針尖陣列之特性分析 | 60 |
| 5.3.1 PMMA 奈米針尖陣列之表面形貌 | 60 |
| 5.3.2 PMMA 奈米針尖陣列之反射率光譜分析 | 64 |
| 5.3.3 PMMA 奈米針尖陣列之接觸角分析 | 69 |
| 第六章 結論 | 72 |
| 第七章 未來研究與建議 | 75 |
| 參考文獻 | 76 |

表目錄

| 33 |
|----|
| |
| 34 |
| 47 |
| 49 |
| 50 |
| 52 |
| 53 |
| 55 |
| |



圖目錄

| 圖 1.1 入射光通過不同介質所產生的反射與穿透1 |
|---|
| 圖 1.2 抗反射膜(AR film)使用效果(左上:無 AR 右下:有 AR) |
| 圖 1.3 抗反射(AR)塑膠膜片結構4 |
| 圖 1.4 非均質層之結構示意圖(a)次波長結構、(b)多孔性的膜層5 |
| 圖 1.5 成長薄膜之間所引起的熱膨脹破裂10 |
| 圖 1.6 塗層壓力不均勻產生蠕蟲狀的痕跡10 |
| 圖 2.1 (a)Nature 期刊中的仿蛾眼表面結構之電子顯微鏡影像、(b)反射 |
| 率光譜圖14 |
| 圖 2.2 (a) 表面結構形式不同所相對應不同的漸變折射率之示意圖、 |
| (b) 不同深度的蛾眼結構之電子顯微鏡影像圖15 |
| 圖 2.3 (a) 週期性的矽次波長結構之 SEM 影像圖、(b)矽基板與矽次波 |
| 長結構之反射率光譜圖 |
| 圖 2.4 矽基板表面的圓柱狀奈米結構之 AFM 影像圖17 |
| 圖 2.5 不同深度的奈米結構在不同波長範圍的反射率情形18 |
| 圖 2.6 陽極氧化鋁模版微影技術製作次波長結構流程圖19 |
| 圖 2.7 (a)週期性的陽極氧化鋁模版、(b)矽次波長結構之 SEM 影像圖 |
| (c)次波長結構反射率光譜圖20 |
| 圖 2.8 (a) 奈米轉印蝕刻大面積的矽奈米柱陣列之製造流程、(b) 矽的 |
| 次波長抗反射結構之 SEM 影像圖 |
| 圖 2.9 次波長抗反射結構之反射率光譜圖 |

| 圖 2.10 以全像曝光技術製作母模版流程 |
|--|
| 圖 2.11 全像曝光技術的 AR 結構之 SEM 影像圖 |
| 圖 2.12 在 PMMA 基材表面兩面製作抗反射膜結構所得反射率光譜圖 |
| |
| 圖 2.13 陽極處理與 SF6 氣體對矽基板蝕刻方式24 |
| 圖 2.14 矽奈米孔洞柱狀次波長結構 (a)上視圖 (b)橫截面影像 24 |
| 圖 2.15 在矽基材表面製作抗反射孔洞柱狀結構所得反射率光譜24 |
| 圖 2.16 等效介質理論之表面結構分割示意圖 (a)多層膜堆的折射率形 |
| 式、(b)連續的梯度折射率模式25 |
| 圖 2.17 RCWA 與 EMT 兩種理論對二維結構不同入射角度之反射率分 |
| 析圖 |
| 圖 2.18 二維 Yee 晶格只考慮 E 場極化 |
| 圖 2.19 三維 Yee 晶格 |
| 圖 2.20 自組裝奈米遮蔽乾蝕刻機制之示意圖:(1)電漿蝕刻的反應 |
| 氣體(CH ₄ +SiH ₄ +Ar+H ₂)、(2) 奈米級保護顆粒的形成、(3) 物 |
| 理性蝕刻形成奈米針尖陣列31 |
| 圖 3.1 Rsoft CAD 視窗建立 2D 模式 |
| 圖 3.2 (a)三角錐結構平面示意圖 (b)三角錐結構三維示意圖 |
| 圖 3.3 連續型之三維三角錐結構 |
| 圖 3.4 (a)半圓形柱結構平面示意圖 (b)半圓形柱結構三維示意圖 34 |
| 圖 3.5 連續型之半圓形柱結構 |

| 圖 3.6 不同深寬比長度的三角錐結構在可見光波段(a)穿透率光譜 (b |) |
|--|----|
| 反射率光譜3 | 6 |
| 圖 3.7 不同深寬比長度的半圓形柱結構在可見光波段(a)穿透率光譜 | |
| (b)反射率光譜3 | 7 |
| 圖 3.8 不同的深寬比長在各光波段部份的反射率關係(a)三角錐結構 | |
| (b)半圓柱結構 | 9 |
| 圖 4.1 實驗流程圖4 | 0. |
| 圖 4.2 電子迴旋共振微波電漿化學氣相沈積系統 (a) 系統結構示意 | |
| (b) 實體圖(台大凝態研究中心.尖端材料實驗室)4 | 2 |
| 圖 4.3 精密電鑄設備 | 4 |
| 圖 4.4 精密電鑄設備外部控制部分 (a)定電流模式之電源供應器 (b) |) |
| 電鑄槽溶液的溫度控制 | 4 |
| 圖 4.5 電鑄槽內部裝置 | 5 |
| 圖 4.6 微熱壓成形機4 | 6 |
| 圖 4.7 模溫機4 | 6 |
| 圖 4.8 LabView 圖控式操作介面4 | 7 |
| 圖 4.9 場發射掃描式電子顯微鏡4 | 8 |
| 圖 4.10 紫外光/可見光/紅外光分光光譜儀 (a) MODELV.570(b)量測 | |
| 穿透率模组 (c) 量測反射率模组4 | 8 |
| 圖 4.11 接觸角量測儀系統 (a) FTA125 設備 (b)軟體操作介面(c)分材 | 斤 |
| 量測角度5 | 0 |

圖 5.1 各種不同長度的矽奈米針尖之 SEM 橫截面影像 (a)320 nm

圖 5.7 不同長度的 PMMA 奈米針尖在可見光波段之反射率光譜.....64 圖 5.8 不同深寬比的 PMMA 奈米針尖在 550 nm 可見光波段時之反射